## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-153910

(43) Date of publication of application: 27.05.1992

(51)Int.CI.

G11B 5/66 5/704 G11B G11B 5/716

G11B 5/82

(21)Application number: 02-276109

(71)Applicant:

NIPPON SHEET GLASS CO LTD

(22)Date of filing:

15.10.1990

(72)Inventor:

**KOGURE TOSHIHIRO** 

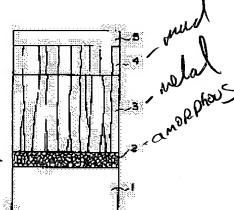
KATAYAMA SHINYA

#### (54) MAGNETIC RECORDING MEDIUM

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To improve the crystallinity of a magnetic layer and to obtain a recording medium having high coercive force by forming an amorphous or microcrystalline layer as a first underlayer and a metal layer as a second

CONSTITUTION: A nonmagnetic substrate 1 is successively coated with an amorphous or microcrystalline layer as a first underlayer 2, a metal layer as a second underlayer 3, a magnetic layer 4 and a protective layer 5. Since the first underlayer 2 affects crystal growth at the time of forming the second underlayer 3 and the magnetic layer 4 and inhibits the considerable increase of the grain size of the layer 4, the coercive force of the layer 4 is increased and medium noise is reduced. The crystallinity of the magnetic layer is improved and a recording medium having high coercive force is obtd.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

8730-05

# ⑩日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

## 平4-153910 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

filnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成 4年(1992) 5月27日

G 11 B 5/66

5/704 5/716 5/82

C

7177-5D

7215-5D 7215-5D 7177-5D

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全6頁)

の発明の名称

磁気記録媒体

頤 平2-276109 ②特

平 2(1990)10月15日 29出

暮 明 者 小 ②発

博

大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号

式会社内

明 者 片 Ш 四発

慎 也 大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本板硝子株

式会社内

顧 人 の出

日本板硝子株式会社

大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号

弁理士 大野 精市 倒代 理

#### 明細曹

## 1. 発明の名称

## 磁気記録媒体

- 特許請求の範囲
- 1 ) 非磁性支持体上に下地層、磁性層、保護層が 順次積層されている磁気記録媒体において、 前記 下地層が前記非磁性支持体側から数えて第1の下 地層と第2の下地層とからなり、 前記第1の下地 層が非晶質の層または微結晶からなる層であり、 前記第2の下地層が金属の層であることを特徴と する磁気記録媒体。
- 前記第1の下地層が、Ti, Zr, Hf, V。 N b, T a, C r, M o およびW からなる金属群 から通ばれた1種の金属とYとからなることを特 徴とする特許請求範囲第1項に記載の磁気記録媒 体。
- 3) 前記第1の下地圏の浮みが10~50 nmで あることを特徴とする特許請求範囲第1項ないし 第2項に記載の磁気記録媒体。
- 4)前記第1の下地層が丁iとYとからなる層で

- あり、 前記第2の下地層がCrの層であることを 特徴とする特許額求範囲第2項または第3項に記 載の磁気記録媒体。
- 5 ) 前記第 1 の下地層と前記非磁性支持体との間 前記保護層の表面に凹凸を形成するように凹 凸形成層が設けられたことを特徴とする特許請求 範囲第1項ないし第4項のいずれかの項に記載の 磁気記錄媒体。
- 3. 発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

本発明は、 情報記録する磁気ディスク装置に用 いられる磁気記録媒体に関し、詳しくは磁性層の 下に改良された下地層を有する磁気記録媒体に関 する。

「従来の技術」

現在コンピューターなどの外部記録装置として は、 磁気記録装置が用いられている。 なかでも 職 気記録媒体として硬質なディスク基板を用いたへ ードディスク型の磁気記録装置は、 大容量でアク セス速度が早いため広く普及しつつある。 そして

# 「、発明が解決しようとする課題」

しかしながら、上記の従来技術に開示されている世気記録媒体では、下地層の厚みを厚くすることなく避性層の保持力を大きくできるという利点を有するが、得られる世気記録媒体の保証力は、前記の公報に関示されているように10000 e 程度であり、高保証力を要求される世気記録媒体としては必ずしも要求を満たすものではないという問題点があった。

たころで、 避気記録媒体の保証力は、 避性層の 結晶粒径や結晶の配向などの結晶特性に関係し、 なかでも結晶粒径に密接に関係することが知られ ている。 また避性層は下地層の上に積層されると

層であることを特徴とする。 ここでいう敬結晶とは第2の下地層あるいは磁性層の結晶粒径よりも小さい結晶粒径であって、 10 n m以下であることが好ましい。

第1の下地層としては、前記のように非晶質の 層であるか微結晶の層であるか微結晶を含む非晶 質の層であれば、とくに層を構成する材料は限定 されないが、 非磁性支持体との密着性がよく、 か つ、第2の下地層、磁性層、保護層を順次形成す るときに非避性支持体から放出され磁気特性に悪 い影響を及ぼす水分などのガスを吸蔵し、 第2の 下地層や磁性層にガスが到遠しないようなガスの パリヤーとなりうるものが好ましい。 このような ものとして、Ti. Zr. Hf. V. Nb. Ta, Cr. MoおよびWからなる金属群から選ばれた 1種の金属とY(イットリウム)とからなる非晶 質の磨や、微粧晶層や微粧晶を含む非晶質の層が 例示ができる。 TiとY, ZrとY, HiとY, V & Y, N b & Y, T a & Y, C r & Y, M o & Y、WとYの二成分系では、Yが2~20%と広 きに、 その結晶特性なかでも結晶粒径は、 下地間の結晶粒径や表面状態により影響を受けるを増加られている。 したがって高保磁力の磁性層を 移動することが重要であって、 それに は磁性圏に 地間の することが重要であって、 かつ前記下地間の材料を適切に選び、 かつ前記下地間の結晶成長を制御することが重要である。

本発明の目的は、下地層を改良することにより 磁性層の結晶性を改良し、もって高保磁力の磁気 記録媒体を提供するにある。

#### 「課題を解決するための手段」

本発明は、非磁性支持体上に下地層、磁性層、保護圏が順次着圏されている磁気記録媒体であって、前記下地層が前記非磁性支持体側から数えて第1の下地層と第2の下地層とからなり、前記第1の下地層が非晶質の瘤または微結晶からなる層であり、前記第2の下地層が金属の層である磁気記録媒体である。

本発明にかかる第1の下地層は、非晶質の層であるか散結晶の層であるか散結晶を含む非晶質の

い組成範囲にわたってYが一方の金属に固溶しない非晶質または微結晶質の薄膜層が得られる。 また、上記の金属群から複数を選ぶこともできる。

磁性層に接して設けられる本発明にかかる第2の下地層としては、金属の結晶層であることに接受しては、金属の結晶層であることに接近される磁性層の結晶の面間隔に近い面間を移し、かつ第1の下地層により結晶粒径の成長が制御されるものが好ましい。磁性層がコパルトークロムータンタル系などの場合、このよ

このような装置に用いられる磁気ディスクの基板としてアルミニウムの基板が用いられ、さらに高密度の磁気記録を実現するために平坦性がよいがラス基板が用いられつつある。 特別平1-173427号公報には、 磁性層と非磁性支持体との間に相異なる金属からなる2層の下地層を介在させて磁気特性を改善したものが開示されている。

「発明が解決しようとする課題」

しかしながら、上記の従来技術に関示されている 型気記録媒体では、下地層の厚みを厚くすることなく 選性層の保持力を大きくできるという利点を有するが、 得られる 磁気記録媒体の保磁力は、 前記の公報に関示されているように 10000 e 程度であり、 高保磁力を要求される 磁気記録媒体 としては必ずしも要求を満たするのではないという問題点があった。

たころで、磁気記録媒体の保磁力は、磁性層の 結晶粒径や結晶の配向などの結晶特性に関係し、 なかでも結晶粒径に密接に関係することが知られ ている。また磁性層は下地層の上に積層されると

層であることを特徴とする。 ここでいう微結晶とは第2の下地層あるいは磁性層の結晶粒径よりも小さい結晶粒径であって、 10 n m 以下であることが好ましい。

第1の下地層としては、前記のように非晶質の 魔であるか敬結晶の層であるか微結晶を含む非晶 質の層であれば、とくに層を構成する材料は限定 されないが、非磁性支持体との密着性がよく、か つ、第2の下地層、磁性層、保護層を順次形成す るときに非避性支持体から放出され避気特性に悪 い影響を及ぼす水分などのガスを吸蔵し、 第2の 下地層や磁性層にガスが到速しないようなガスの パリヤーとなりうるものが好ましい。 このような boelt, Ti. Zr. Hi, V. Nb. Ta. Cr. MoおよびWからなる金属群から選ばれた 1種の金属とY(イットリウム)とからなる非晶 質の層や、微結晶層や微結晶を含む非晶質の層が 例示ができる。 TiとY. ZェとY. HfとY. VłY, NbłY, TałY, CrłY, Moł Y、WとYの二成分系では、Yが2~20%と広

きに、 その結晶特性なかでも結晶粒径は、 下地 周の結晶粒径や表面状態により影響を受けることが 知られている。 したがって高保磁力の磁性層を得るには、 磁性層が接する下地層の結晶状態を制御することが重要であって、 それには磁性圏に 地層の結晶成長を制御することが重要である。

本発明の目的は、下地層を改良することにより磁性層の結晶性を改良し、もって高保証力の磁気記録媒体を提供するにある。

#### 「課題を解決するための手段」

本発明は、非磁性支持体上に下地層、磁性層、 保護周が順次積層されている磁気記録媒体であっ て、前記下地層が前記非磁性支持体側から数えて 第1の下地層と第2の下地層とからなり、前記第 1の下地層が非晶質の層または微結晶からなる層 であり、前記第2の下地層が金属の層である磁気 記録媒体である。

本発明にかかる第1の下地層は、非晶質の層であるか散結晶の層であるか散結晶を含む非晶質の

い組成範囲にわたってYが一方の金属に固溶しない非晶質または微結晶質の薄膜層が得られる。 また、上記の金属群から複数を選ぶこともできる。

第2の下地層が大きい保持力をもった戦気記録 媒体を得る上で好都合に結晶成長するためで50 n mの範囲とするのが好ましい。第1の下地層の みが10nmとするのが好ましい。第1の下地層 みが10nmとするのが好ましい。第1の下地層 の時晶成長を調整することが困難になり、また5 の n m より厚いと第1の下地層の結晶粒径が大き くなるので好ましくない。

せ性層に接して設けられる本発明にかかる第2の下地層としては、 金属の結晶層であること上に 被置される 世世層の 結晶の面間隔に近い面間隔を 有し、かつ第1の下地層により結晶粒径の成長が 制御されるものが好ましい。 磁性層がコベルトーニッケル系、 コパルトーニッケル 不 この場合、このよ

AGE BLANK (USPTO)

うな金属層としては、 Cr、 Bi などの層が例示でき、 とりわけ Crの層が好ましい。

また、本発明において、第1の下地層と非磁性 支持体との間に、保護層のの表面に凹凸を形成する。 このではないできる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。こことができる。ここの用いる凹凸形成層では、非磁性を密を性がよい。 のが好ましく、AI、AB、CU、BI、Snなどのが好ました。AI、ABが好んで用いるというにはないで用いる。 のでは、またいのでは、第1の下地層と非磁性である。そして前記凹凸形成層は、連続膜として介在磁性であるとは、たと対けてもよい。

本発明の磁気記録媒体の第1の下地層、第2の下地層、磁性層および保護層さらには、凹凸形成層は、公知のスパッタリング法により連続的につつのプロセスとして形成することができる。 そして第1の下地層の形成にあたっては、 非磁性支持体は室温の状態で形成してもよい。また加熱温度は第2の下地層

潤滑袖を塗布することができる。

本発明にかかる非磁性支持体としては、ソーダ ライム組成や硬珪酸組成のガラス基板やアルミニ ウム基板を用いることができる。

#### 「作用」

本発明にかかる非晶質または微結晶質からなる 第1の下地層は、その上に順次積層される第2の 下地層および磁性層が形成されるに際して、 結晶 成長に影響を及ばし、磁性層の結晶粒径が大きく 成長するのを抑制する。 これにより磁性層は保磁 力が大きくかつ媒体ノイズが小さくなる。

#### 「実施例」

本免明を以下に実施例に基づいて説明する。 第1図は、本発明の磁気記録媒体の一部断面図で、 非磁性支持体1の上に非晶質または散結晶質の第 1の下地層2が被覆され、第1の下地層2の上に 第2の金属の下地層3が被覆され、第2の下地層 3の上に磁性層4が被覆され、さらに磁性層4の 上に保護層5が被覆されている。第2図は比較例 の磁気記録媒体の一部断面図で、非磁性支持体1 および避性層を形成するときの温度域と同じの 2 5 0 ~ 4 0 0 でとすることができる。

第2の下地層の形成にあたっては、非磁性支持体を加熱した状態でおこなうことは、第2の下地層の結晶性を、高保磁力の磁性層がその上に成長するように制御する上で好ましい。 また第2の下地層の上に積層される磁性層は、第2の下地層の表面からエピタキシャル成長させる上で、 非磁性支持体を加熱した状態で形成するのが好ましい。

また、本発明にかかる凹凸形成層を非磁性を被覆 体上に形成する場合は、低融点金属が基体に被覆 されるときの凝集力を大きくする上で、凹凸形成 層を被覆するときの非磁性支持体の温度に加熱する ことが好ましく、100℃以上に加熱する ことが好ましい。本発明にかかる保護層としができる。 公知のカーボン膜やSi0₂膜を用いることができ、 カーボン膜はたとえばスパッタリング法により、 Si0.膜はスパッタリング法やディッピング法や スピンコート法により形成することができる。 らにこれらの膜の上にパーフロテルキルな

の上に結晶質の第1の下地層8が被覆され、第1の下地層8の上に第2の下地層3が被覆され、第2の下地層3が被覆され、第2位性層4が被覆され、さらに破性層4の上に保護層5が被覆されている。また第1回、第2回の磁気記録媒体を構成する層の結晶粒界が模式的に記されている。

#### 実施例 1

4つのカソードを備えたインライン型スパッタ 装置のカソードに10原子%のYを含むTi、 C r 金属, C o 8 2. 5 % N 1 3 0 % C r 7. 5 % の組成の磁性合金、カーボンをターゲットとして設置した。 そしてよく洗浄されたソーダライムガラス基板 (円盤状に加工され化学強化されたもの)をロード室にセットし、その後スパッタ装置の上記ターゲットが設置されているコーテイング室を駆火機切るように移動させながら上記ターゲットをA r ガスでスパッタリングし、ガラス基板上に下地層、磁性層、保護層を順次被覆した。 第1の下地層は 盗傷のガラス基板に 被覆し、その後ガラス基板を 3 5 0 ℃に加熱し、その程度で第2の

地層、磁性層、保護層を被覆した。ターゲットに加える電力を調整して、30nmのTiとYとからなる第1の下地層、150nmのCrからなる第2の下地層、60nmの磁性層、30nmのカーボンの保護層が順次機層された磁気記録媒体を得た。

得られた磁気記録媒体の保磁力は13500e、 S/N比は40dBであった。

同様な方法でガラス基板の上にTiとYとからなる膜のみを30nm被覆した。この膜をX線回折法で結晶性を調べたところ、Tiの金属結晶に基づく回折ピークは認められなかった。また、電子顕微鏡で観察したところ、粒径が10nm以下の微結晶が観察された。

また、前記の磁気記録媒体とは、保護層のみをを被覆しない最上層が磁性層になっているサンプルを製作し、このサンプルの磁性層表面を電子顕微鏡で観察したところ、この磁性層は約40 n m の粒径の結晶からなっていることが認められた。実施例2

同様な方法でガラス基板の上に T i と Y とからなる 裏のみを 3 0 n m被覆した。 この膜を X 線回折法で結晶性を調べたところ、 T i の金属結晶に基づく回折ピークは認められなかった。 また、 電子顕微鏡で観察したところ、 粒径が 1 0 n m 以下の微結晶が観察された。

また、前記の磁気記録媒体とは、保護層のみをを被覆しない最上層が磁性層になっているサンプルを製作し、このサンビルの磁性層表面を電子顕微鏡で観察したところ、この磁性層は約40 nmの粒径の結晶からなっていることが認められた。 実施例3

実施例1で用いたのと同じインライン型スパッタ装置のカソードに15原子%のYを含むTi、Cr金属。Co82.5%Ni30%Cr7.5%の組成の避性合金、カーボンをターゲットとして設置した。そしてよく洗浄された学強化されたもがラス基板(円盤状に加工され化学強化されたもの)をロード室にセットし、その後スパッタ装置の上記ターゲットが設置されているコーティング

実施例1で用いたのと同じインライン型スパッ タ装置のカソードに3原子%のYを含むTi、 C r金属, Co62. 5%Ni30%Cr7. 5% の租成の磁性合金、 カーポンをターゲットとして 設置した。 そしてよく先浄されたソーダライムガ ラス基板(円盤状に加工され化学強化されたもの) をロード室にセットし、その後スパッタ装置の上 記ターゲットが設置されているコーティング室を 顧次横切るように移動させながら上記ターゲット をスパッタリングし、 ガラス基板上に下地層、磁 性層、保護層を順次被覆した。第1の下地層は室 塩のガラス基板に被覆し、 その後ガラス基板を3 50℃に加熱し、その温度で第2の下地層、磁性 層、 保護暦を被覆した。 ターゲットに加える電力 を調整して、30nmのTiとYとからなる第1 の下地層、 150 nmのCrからなる第2の下地 層、60mmの磁性層、30mmのカーボンの保 護層が順次後層された磁気記録媒体を得た。

得られた磁気記録媒体の保磁力は13500e、 S/N比は40dBであった。

室を順次接切るように移動させながら上記ターゲットをスパッタリングし、ガラス基板上に下地層、磁性層、保護層を順次被覆した。 第1の下地層は窒温のガラス基板に被覆し、 その後ガラス基板を350℃に加熱し、 その温度で第2の下地層、磁性層、保護層を被覆した。 ターゲットに加える電力を調整して、30nmのTiとYとからなる第1の下地層、150nmのCrからなる第2の下地層、150nmのCrからなる第2の下地層、60nmの磁性層、30nmのカーボンの保護層が順次検層された磁気記録媒体を得た。

得られた磁気記録媒体の保磁力は13500e、 S/N比は40dBであった。

同様な方法でガラス基板の上にTiとYとからなる膜のみを30nm被覆した。この膜をX線回折法で結晶性を調べたところ、Tiの金属結晶に基づく回折ピークは認められなかった。また、電子顕微鏡で観察したところ、粒径が10nm以下の散結晶が観察された。

また、前記の磁気記録媒体とは、保護層のみを を被覆しない最上層が磁性層になっているサンプ 地層、磁性層、保護層を被覆した。ターゲットに加える電力を調整して、30nmのTiとYとからなる第1の下地層、150nmのCrからなる第2の下地層、60nmの磁性層、30nmのカーボンの保護層が順次積層された磁気記録媒体を得た。

得られた磁気記録媒体の保磁力は13500e、 S/N比は40dBであった。

同様な方法でガラス基板の上にTiとYとからなる膜のみを30mm被覆した。この膜をX線回折法で結晶性を調べたところ、Tiの金属結晶に基づく回折ピークは認められなかった。また、電子顕微鏡で観察したところ、粒径が10mm以下の微結晶が観察された。

また、前記の磁気記録媒体とは、保護層のみをを被覆しない最上層が磁性層になっているサンプルを製作し、このサンプルの磁性層表面を電子顕微鏡で観察したところ、この磁性層は約40 n m の粒径の結晶からなっていることが認められた。 実施例2

同様な方法でガラス基板の上にTiとYとからなる裏のみを30mm被覆した。 この膜をX線回折法で結晶性を調べたところ、 Tiの金属結晶に基づく回折ビークは認められなかった。 また、電子顕微鏡で観察したところ、 粒径が10mm以下の微結晶が観察された。

また、前記の磁気記録媒体とは、保護層のみを を被覆しない最上層が磁性層になっているサンプルを製作し、このサンビルの磁性層表面を電子顕 微鏡で観察したところ、この磁性層は約40 nm の粒径の結晶からなっていることが認められた。 実施例3

実施例1で用いたのと同じインライン型スパッタ装置のカツードに15原子%のYを含むTi、Cr金属, Co62. 5%Ni30%Cr7. 5%の組成の磁性合金、カーボンをターゲットとして設置した。そしてよく洗浄されたソーダライムガラス基板(円盤状に加工され化学強化されたもの)をロード窓にセットし、その後スパッタ装置の上記ターゲットが設置されているコーティング

実施例1で用いたのと同じインライン型スパッ 夕装置のカソードに3原子%のYを含むTi、C г 金属。 Соб2. 5 % N i 3 0 % C r 7. 5 % の組成の磁性合金、 カーポンをターゲットとして 設置した。 そしてよく洗浄されたソーダライムガ ラス基板(円盤状に加工され化学強化されたもの) をロード室にセットし、その後スパッタ装置の上 記ターゲットが設置されているコーティング室を 顧次横切るように移動させながら上記ターゲット をスパッタリングし、ガラス基板上に下地層、磁 性層、保護層を順次被覆した。第1の下地層は室 塩のガラス基板に被覆し、その後ガラス基板を3 50℃に加熱し、その湿度で類2の下地層、磁性 題、 保護層を被覆した。 ターゲットに加える電力 を調整して、30nmのTiとYとからなる第1 の下地層, 150 nmのCrからなる第2の下地 眉、 60 n m の磁性層、 30 n m のカーポンの保 護層が順次後層された磁気記録媒体を得た。

得られた磁気記録媒体の保磁力は13500e、 S/N比は40dBであった。

室を順次様切るように移動させながら上記ターゲットをスパッタリングし、ガラス基板上に下地層、磁性層、保護層を順次被覆した。 第1の下地層は室温のガラス基板に被覆した。 ターゲットに加える電性層、保護層を被覆した。 ターゲットに加える電力を調整して、30nmのTiとYとからなる第1の下地層、150nmのCrからなる第1の下地層、150nmのCrからなる第1の下地層、30nmのカーボンの保護層が順次機圏された磁気記録媒件を得た。

得られた 磁気記録媒体の保磁力は 1 3 5 0 0 e、 S / N 比は 4 0 d B であった。

同様な方法でガラス基板の上にTiとYとからなる膜のみを30nm被理した。この膜をX線回折法で結晶性を割べたところ、Tiの金属結晶に基づく回折ビークは認められなかった。また、電子顕微鏡で観察したところ、粒径が10nm以下の微結晶が観察された。

また、前記の磁気記録媒体とは、保護層のみを を被覆しない最上層が磁性層になっているサンプ

ルを製作し、このサンブルの避性層表面を電子顕微鏡で観察したところ、この避性層は約40 nmの粒径の結晶からなっていることが認められた。 実施例4

第1の下地層、第2の下地層、磁性層、保護圏のすべての圏をガラス基板を350℃に加熱した状態で被覆したことのほかは、実施例1と同じようにして、30nmので1とYとからなる第1の下地層、150nmので「からなる第2の下地層、60nmの磁性圏、30nmのカーボンの保護圏が順次積層された磁気記録媒体を得た。

得られた磁気記録媒体の保磁力は13500e、 S/N比は40dBであった。

同様な方法でガラス基板の上に TiとYとからなる膜のみを30nm被覆した。 この膜をX線回折法で結晶性を調べたところ、 Tiの金属結晶に基づく回折ピークは認められなかった。 また、電子顕微鏡で観察したところ、 粒径が10nm以下の微結晶が観察された。

また、前記の磁気記録媒体とは、保護層のみを

ろ、 粒径が30 n m 程度の結晶が観察された。

また、前記の磁気記録媒体の比較サンプルとは、 保護層を被覆しない点でのみ異なる、 最上層が磁性層になっているサンプルを製作し、 このサンプルの磁性層表面を電子顕微鏡で観察したところ、 この磁性層は約100nmと大きい粒径の結晶からなっていることが認められた。

以上より、本発明の第1の下地層は、磁性層に接する第2の下地層を介して磁性層の結晶粒径が大きくなるのを抑制し、高保磁力の磁性層とすることが分かる。またこの第1の下地層は、室温の基板および加熱された基板のいずれの基板にも形成できることが分かる。

#### 「発明の効果」

本発明の磁気記録媒体は、下地層により磁性層の結晶粒径が制御されているので高保持力を有するとともに、媒体ノイズが小さい。 また、 本発明の磁気記録媒体を構成する薄膜層を形成するにあたっては、 薄膜層のすべてを間一温度域で形成することができる。

を被覆しない最上層が磁性層になっているサンプルを製作し、このサンブルの磁性層表面を電子顕微鏡で観察したところ、この磁性層は約40nmの粒径の結晶からなっていることが認められた。 比較例1

実施例1で用いたスパッタ装置で、 1 0 原子%のYを含むTiの代わりに、 Ti金属をターゲットとして設置し用いたことの他は全く同じようにして、下地層、 磁性層、 保護層を順次被覆した。これにより、 3 0 n mの T i 金属からなる第1の下地層、 15 0 n m の C r からなる第2の下地層、6 0 n m の磁性層、30 n m のカーボン保護層が順次複層された磁気記録媒体の比較サンブルを得

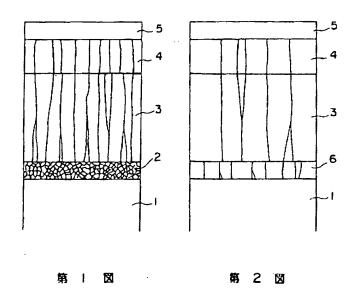
得られた磁気記録媒体の比較サンブルの保磁力は12000e、S/N比は38dBであった。

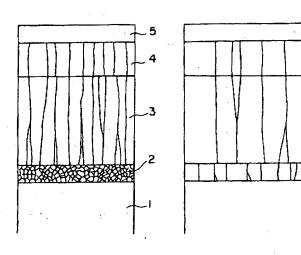
同様な方法でガラス基板の上にTi膜のみを30nm被覆した。この膜をX線回折法で結晶性を 調べたところ、Tiの金属結晶に基づく回折ピー クが認められた。また電子顕微鏡で観察したとこ

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の磁気記録媒体の一実施例の 一部断面図で、第2図は比較例の磁気記録媒体の 一部断面図である。

1 ・・・非磁性支持体、 2 ・・・非晶質または微結晶質の第1の下地層、 3 ・・・第2の下地層、 4 ・・・磁性層、 5 ・・・保護層、 8 ・・・結晶質の第1の下地層





第一図

第 2 図

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.